(19)中華民國智慧財產局
(12)發明說明書公開本 (11)公開編號：TW 200947603 A1
(43)公開日： 中華民國 98 (2009) 年 11 月 16 日

(21)申請案號：098103696 (22)申請日： 中華民國 98 (2009) 年 02 月 05 日
(51)Int. Cl.： *H01L21/683 (2006.01)* *H01L21/3065(2006.01)*
(30)優先權：2008/02/08 日本 2008-029189
(71)申請人：東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本
(72)發明人：鈴木隆司 SUZUKI, TAKASHI (JP) ；安田要 YASUDA, KANAME (JP) ；山崎良 YAMASAKI, RYO (JP)
(74)代理人：周良謀；周良吉
申請實體審查：有 申請專利範圍項數：8 項 圖式數：2 共 17 頁

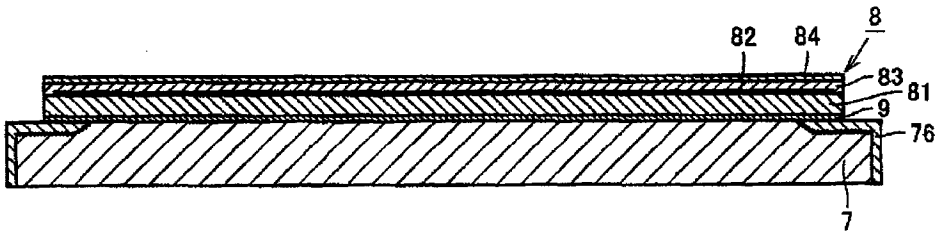
(54)名稱

電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法

SUBSTRATE MOUNTING STAND FOR PLASMA PROCESSING DEVICE, PLASMA PROCESSING DEVICE, AND INSULATING COATING DEPOSITION METHOD

(57)摘要

本發明之課題為：提供電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法，可使基座頂面平坦，並可將基座部與靜電吸盤部良好地固定。為解決上述課題，包含：用以吸附待處理基板的靜電吸盤部 8、及用以固持靜電吸盤部 8 的基座部 7；基座部 7 具有高度較高之凸部 72、及凸部 72 周圍之比凸部 72 低既定高度之位置所形成的外周面 71；在外周面 71 上，將膜壓相等於凸部 72 及外周面 71 之高度的噴敷皮膜 76 疊層，以使凸部 72 及噴敷皮膜 76 之面連接而平坦形成；且在絕緣性構件 81、83、84 之間配設電極 82，以構成靜電吸盤部 8，並覆蓋凸部 72 頂面及噴敷皮膜 76 面之分界，而於基座部 7 以黏接劑 9 將靜電吸盤部 8 固定。



7：基座部
8：靜電吸盤部
9：黏接劑
76：噴敷皮膜
81：絕緣性構件(絕緣性基板)
82：電極(金屬膜)
83：絕緣性構件(低電阻陶瓷噴敷皮膜)
84：絕緣性構件(高電阻陶瓷噴敷皮膜)

(19)中華民國智慧財產局
(12)發明說明書公開本 (11)公開編號：TW 200947603 A1
(43)公開日： 中華民國 98 (2009) 年 11 月 16 日

(21)申請案號：098103696 (22)申請日： 中華民國 98 (2009) 年 02 月 05 日
(51)Int. Cl.： *H01L21/683 (2006.01)* *H01L21/3065(2006.01)*
(30)優先權：2008/02/08 日本 2008-029189
(71)申請人：東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本
(72)發明人：鈴木隆司 SUZUKI, TAKASHI (JP) ；安田要 YASUDA, KANAME (JP) ；山崎良 YAMASAKI, RYO (JP)
(74)代理人：周良謀；周良吉
申請實體審查：有 申請專利範圍項數：8 項 圖式數：2 共 17 頁

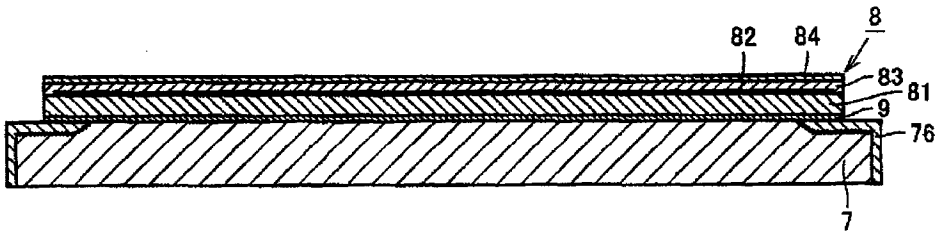
(54)名稱

電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法

SUBSTRATE MOUNTING STAND FOR PLASMA PROCESSING DEVICE, PLASMA PROCESSING DEVICE, AND INSULATING COATING DEPOSITION METHOD

(57)摘要

本發明之課題為：提供電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法，可使基座頂面平坦，並可將基座部與靜電吸盤部良好地固定。為解決上述課題，包含：用以吸附待處理基板的靜電吸盤部 8、及用以固持靜電吸盤部 8 的基座部 7；基座部 7 具有高度較高之凸部 72、及凸部 72 周圍之比凸部 72 低既定高度之位置所形成的外周面 71；在外周面 71 上，將膜壓相等於凸部 72 及外周面 71 之高度的噴敷皮膜 76 疊層，以使凸部 72 及噴敷皮膜 76 之面連接而平坦形成；且在絕緣性構件 81、83、84 之間配設電極 82，以構成靜電吸盤部 8，並覆蓋凸部 72 頂面及噴敷皮膜 76 面之分界，而於基座部 7 以黏接劑 9 將靜電吸盤部 8 固定。



7：基座部
8：靜電吸盤部
9：黏接劑
76：噴敷皮膜
81：絕緣性構件(絕緣性基板)
82：電極(金屬膜)
83：絕緣性構件(低電阻陶瓷噴敷皮膜)
84：絕緣性構件(高電阻陶瓷噴敷皮膜)

六、發明說明：

【發明所屬之技術領域】

【0001】

本發明係關於電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法，在電漿處理裝置內載置半導體晶圓等之待處理基板，以利用該電漿而進行例如蝕刻處理、成膜處理等。

【先前技術】

【0002】

例如，於半導體裝置的製造領域，形成半導體裝置之細微的電路構造時，以電漿處理裝置使電漿對半導體晶圓等之待處理基板起作用，以進行蝕刻處理或成膜處理等。

【0003】

此種電漿處理裝置中，由於在減壓環境之真空腔室內的電漿處理室配置待處理基板，以進行電漿處理，故難以利用真空吸盤吸附固持待處理基板。因此，有人使用靜電吸盤(Electrostatic Chuck)作為用以吸附固持待處理基板的機構。靜電吸盤係於陶瓷等絕緣性構件間配設由鎢等構成之靜電吸盤用電極而構成，並對靜電吸盤用電極施加直流電壓，而以庫侖力等吸附固持待處理基板。

【0004】

又，電漿處理裝置中，載置待處理基板之基板載置台兼作為下部電極，基板載置台之基座部必須以鋁等導電性的金屬等構成。因此，就基板載置台而言，如日本特開2004-47653號公報(專利文獻 1)記載，在由鋁等構成之基座部，將另成一體所構成之靜電吸盤部之由陶瓷等構成的絕緣性構件以黏接劑黏著而構成，係廣為人知。

【0005】

基板載置台係在由鋁等構成之基座部上，固定由陶瓷等構成之靜電吸盤部所構成。基座部之表面形成有絕緣皮膜，俾於不會暴露在腐蝕性較高的處理氣體；而絕緣皮膜上固定著靜電吸盤

部。為使絕緣皮膜之端部不會暴露在處理氣體，專利文獻 1 中，設置溝槽等空隙部，使絕緣皮膜之端部抵接空隙部，並對該空隙部供應氦氣。

【專利文獻 1】日本特開 2004-47653 號公報

【發明內容】

發明所欲解決之課題

【0006】

然而，若在基座設置溝槽等空隙部，不僅構造變複雜，由於產生厚度不同的部分，因此難以控制成使溫度及高頻成為平均。又，由於在基座上固定靜電吸盤部，故必須使基座頂面盡可能平坦；厚度不均等而不平坦時，必須藉由用以固定之黏著劑的厚度，以吸收厚度之不均。

【0007】

因此，本發明之目的為：提供電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法，可使基座頂面平坦，並可將基座部與靜電吸盤部良好地固定。

解決課題之手段

【0008】

本發明係一種電漿處理裝置用基板載置台，包含：基座，由下列部分構成頂面：第 1 面、第 1 面周圍之較低既定高度之位置所形成的第 2 面、及膜厚相同於既定高度且與第 1 面連接而形成於第 2 面上的絕緣皮膜；靜電吸盤部，固定於基座之頂面以固持待處理基板。

【0009】

藉由與第 1 面連接之方式而在高度較低之第 2 面形成絕緣皮膜，可將基座頂面形成平坦狀，故能使靜電吸盤之固定狀態良好。

【0010】

較佳係包含形成於基座之第 1 面及第 2 面之分界的傾斜面。藉由在傾斜面上形成絕緣皮膜，可使絕緣皮膜之端部不容易剝落。

【0011】

絕緣皮膜較佳為陶瓷膜。

【0012】

本發明之另一態樣為一種電漿處理裝置，包含上述任一項之電漿處理裝置用基板載置台。

【0013】

本發明之又另一態樣為一種絕緣皮膜之成膜方法，在具有第 1 面、及比第 1 面低既定高度之位置所形成之第 2 面的基座，將膜厚相同於既定高度並與第 1 面連接之方式形成於第 2 面上的該絕緣皮膜成膜，包含：於表面上將絕緣皮膜噴敷的步驟；藉由去除位於表面上之比第 1 面上方的絕緣皮膜，以使絕緣皮膜之膜厚一致於既定高度的步驟。

【0014】

較佳係包含在第 1 面及第 2 面之間形成傾斜面的步驟。

【0015】

較佳係在第 1 面之周圍形成第 2 面，且包含一步驟，除第 1 面之周緣以外，以遮蔽構件遮蔽；將絕緣皮膜噴敷的步驟除遮蔽構件上以外，噴敷絕緣皮膜。

【0016】

較佳係包含將第 1 面上之周緣、第 2 面、及傾斜面粗糙化的步驟。藉由進行粗糙化，可提高噴敷皮膜之密接性。

<u>發明之效果</u>

【0017】

依本發明，由於在比基座之第 1 面低既定高度之位置形成第 2 面，並與第 1 面連接而在第 2 面上形成膜厚相等於既定高度的絕緣皮膜，以構成基座之頂面，因此可使基座之頂面平坦，且可在基座之頂面將用以固持待處理基板之靜電吸盤部良好地固定。又，由於在基座頂面形成絕緣膜，因此不會暴露於腐蝕性較高之處理氣體。而且，藉由使基座頂面平坦，而容易控制使溫度、高頻成為平均。

【實施方式】

實施發明之最佳形態

【0018】

圖 1 係顯示本發明之一實施形態之電漿處理裝置的縱剖面圖。圖 1 中，電漿處理裝置 1 包含上部開口之有底圓筒狀的處理容器 2。處理容器 2 係將待處理基板之一例之半導體晶圓 W 可送入送出而收納，並且接地者。處理容器 2 底部設置用以載置半導體晶圓 W 之成為基板載置台的基座 3。基座 3 包含基座部 7 與靜電吸盤部 8。靜電吸盤部 8 以靜電吸附半導體晶圓 W。從設於處理容器 2 外部之交流電源 4，對基座 3 供應偏壓用的高頻電力。

【0019】

處理容器 2 之底部設有排氣管 12，該排氣管 12 用以利用真空泵等之排氣裝置 11 將處理容器 2 內的空氣排出。又，處理容器 2 之側壁部 5 設有氣體導入部 13，該氣體導入部 13 用以從未圖示之處理氣體供應源供應處理氣體。

【0020】

於處理容器 2 之上部開口，隔著用以確保氣密性之密封材 14，由例如石英等之圓形的介電材料構成的頂棚 20 與基座 3 相對而受支撐。又，不使用石英，也可使用其他介電材料。藉由頂棚 20，於處理容器 2 內形成處理空間 S。頂棚 20 之平面形態為圓形。

【0021】

頂棚 20 藉由接受微波，於其背面產生電漿。頂棚 20 之上方設有圓板狀的槽孔天線 30，槽孔天線 30 之頂面設有慢波板 31、及覆蓋慢波板 31 的天線蓋 32。槽孔天線 30 由帶有導電性之材質，如 Ag、Au 等所電鍍之銅的較薄圓板構成，且多數之槽孔 33 呈漩渦狀或同心圓狀排列而形成。

【0022】

天線蓋 32 連接有同軸導波管 35，同軸導波管 35 由內側導體 35a 及外管 35b 構成。內側導體 35a 與槽孔天線 30 連接。內側導

體 35a 之槽孔天線 30 側具有圓錐形，可有效率地對槽孔天線 30 傳遞微波。同軸導波管 35 將微波供應裝置 36 所產生之例如 2.45GHz 的微波，經由負載匹配器 37、同軸導波管 35、慢波板 31、槽孔天線 30 而傳遞到頂棚 20。然後，以其能量在頂棚 20 背面形成電場，將氣體導入部 13 所供應至處理容器 2 內的處理氣體電漿化，對基座 3 上之半導體晶圓 W 進行既定之電漿處理，例如成膜處理或蝕刻處理等。

【0023】

如上述構成之電漿處理裝置 1 中，進行電漿處理時，處理容器 2 內之基座 3 上的靜電吸盤部 8 吸附半導體晶圓 W，且一面從氣體導入部 13 供應既定之處理氣體到處理容器 2 內，一面從排氣管 12 排氣，藉此使處理空間 S 內形成既定之壓力。然後，以交流電源 4 對半導體晶圓 W 施加高頻偏壓，並以微波供應裝置 36 產生微波，而透過頂棚 20 將微波導入處理容器 2 內，以在頂棚 20 之下方產生電場。如此一來，藉由處理空間 S 內之處理氣體被電漿化，並選擇處理氣體的種類等，可對半導體晶圓 W 實施既定之電漿處理，例如蝕刻處理、灰化處理、成膜處理等各種之電漿處理。

【0024】

圖 2(A)～2(E)係用以說明圖 1 所示基座 3 包含之基座部 7、與靜電吸盤部 8 之製造方法的剖面圖。

【0025】

本發明之一實施形態之電漿處理裝置用基板載置台，包含基座部 7、與靜電吸盤部 8。基座部 7 由下列部分構成頂面：成為第 1 面之圓形的凸部 72、凸部 72 周圍之較低既定高度的位置所形成之成為第 2 面的外周面 71、及與凸部 72 連接而形成於外周面 71 上之成為絕緣皮膜的噴敷皮膜 76；該基座部 7 之頂面固定著用以固持待處理基板，即半導體晶圓 W 的靜電吸盤部 8。

【0026】

更具體說明之，如圖 2(A)所示，基座部 7 由鋁冷卻板構成，

外形形狀為圓板狀。於基座部 7，中央形成有高度較高之圓形的凸部 72，凸部 72 周圍之比凸部 72 低既定高度的位置形成有外周面 71。凸部 72 用以在最後完成使基座部 7 之頂面成為平坦面時，作為削除量而形成。從基座部 7 之外周面 71 到凸部 72 形成有緩和的傾斜面 73，凸部 72 之中央部上形成有比周圍低陷的平坦部 74。基座部 7 之此種形態藉由將圓形的鋁板切削加工而可得。

【0027】

如圖 2(B)所示，將基座部 7 之外周面 71 上、與凸部 72 上之周緣進行噴砂處理而粗糙化。又，圖 2(C)所示，除經粗糙化之外周面 71 上與凸部 72 之周緣上以外，將平坦部 74 上與凸部 72 上以遮罩構件 75 遮蔽。然後，於經粗糙化之外周面 71 上與凸部 72 之周緣上形成噴敷皮膜 76。噴敷皮膜 76 以相當於凸部 72 及外周面 71 二者之高度差的厚度而疊層，例如為低電阻陶瓷膜等，膜壓例如選用 350μm。

【0028】

去除如圖 2(C)所示之遮罩構件 75 後，將噴敷皮膜 76 及凸部 72 研磨，以削除比 C－C 線上方的部分；圖 2(D)所示，以使基座部 7 之凸部 72 頂面與噴敷皮膜 76 頂面連接之方式而完成平坦部 74。

【0029】

如圖 2(E)所示，在平坦部 74 上塗佈黏接劑 9，並於其上載置靜電吸盤部 8，以將靜電吸盤部 8 固定在基座部 7 上。靜電吸盤部 8 使用例如日本特開 2006-60040 號公報所記載者。亦即，將成為電極之金屬膜 82 形成於絕緣性基板 81 上，並形成用以覆蓋該金屬膜 82 的低電阻陶瓷噴敷皮膜 83，再於其上將頂面成為靜電吸附面的高電阻陶瓷噴敷皮膜 84 疊層，而形成靜電吸盤部 8。

【0030】

靜電吸盤部 8 除上述方式以外，也可在 2 片基板間插入電極，以衝壓加工進行一體化。

【0031】

如上所述，依本發明之一實施形態，藉由將基座部 7 之上部的外周面 71、與傾斜面 73 粗糙化，再於其上形成噴敷皮膜 76，可形成平坦的基座部 7。並且，由於噴敷皮膜 76 之端部不會露出，故可使噴敷皮膜 76 不容易從外周面 71 與傾斜面 73 剝落。進而，由於將噴敷皮膜 76 及平坦部 74 的分界附近覆蓋而以黏接劑 9 使靜電吸盤部 8 固定，因此噴敷皮膜 76 及平坦部 74 的分界附近不會在電漿處理中與包含腐蝕性較高之氟自由基等的處理氣體接觸，能使噴敷皮膜 76 更不容易剝落。

【0032】

又，從外周面 71 到凸部 72 形成傾斜面 73，但並不限於此，亦可為垂直面。

【0033】

以上已參照圖式說明本發明之實施形態，但本發明不限於所圖示之實施形態。針對所圖示之實施形態，在與本發明相同之範圍或者均等之範圍內，可施加各種之修正或變更。

【產業上利用性】

【0034】

本發明之電漿處理裝置用基板載置台可利用於在電漿處理裝置之處理室內載置半導體晶圓基板。

【圖式簡單說明】

【0035】

圖 1 係顯示本發明之一實施形態之電漿處理裝置的縱剖面圖。

圖 2(A)～2(E)係用以說明圖 1 所示基座 3 包含之基座部 7、及靜電吸盤 8 之製造方法的剖面圖。

【主要元件符號說明】

【0036】

1～電漿處理裝置

2～處理容器
3～基座
4～交流電源
5～側壁部
7～基座(基座部)
8～靜電吸盤(靜電吸盤部)
9～黏接劑
11～排氣裝置
12～排氣管
13～氣體導入部
14～密封材
20～頂棚
30～槽孔天線
31～慢波板
32～天線蓋
33～槽孔
35～同軸導波管
35a～內側導體
35b～外管
36～微波供應裝置
37～負載匹配器
71～外周面
72～凸部
73～傾斜面
74～平坦部
75～遮罩構件
76～噴敷皮膜
81～絕緣性基板(絕緣性構件)
82～金屬膜(電極)
83～低電阻陶瓷噴敷皮膜(絕緣性構件)

84～高電阻陶瓷噴敷皮膜(絕緣性構件)

S～處理空間

W～半導體晶圓

200947603

發明專利說明書

（本說明書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

※申請案號：98103696

※申請日：98.2.5　　※IPC分類：H01L 21/683 (2006.01)
H01L 21/3065 (2006.01)

一、發明名稱：（中文/英文）

電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法 / SUBSTRATE MOUNTING STAND FOR PLASMA PROCESSING DEVICE, PLASMA PROCESSING DEVICE, AND INSULATING COATING DEPOSITION METHOD

二、中文發明摘要：

本發明之課題為：提供電漿處理裝置用基板載置台、電漿處理裝置及絕緣皮膜之成膜方法，可使基座頂面平坦，並可將基座部與靜電吸盤部良好地固定。

為解決上述課題，包含：用以吸附待處理基板的靜電吸盤部8、及用以固持靜電吸盤部8的基座部7；基座部7具有高度較高之凸部72、及凸部72周圍之比凸部72低既定高度之位置所形成的外周面71；在外周面71上，將膜壓相等於凸部72及外周面71之高度的噴敷皮膜76疊層，以使凸部72及噴敷皮膜76之面連接而平坦形成；且在絕緣性構件81、83、84之間配設電極82，以構成靜電吸盤部8，並覆蓋凸部72頂面及噴敷皮膜76面之分界，而於基座部7以黏接劑9將靜電吸盤部8固定。

三、英文發明摘要：

To provide a substrate mounting stand for a plasma processing device in which the upper surface of a base section can be formed flat, and the base section and an electrostatic chuck section can be favorably secured, and to also provide a plasma processing device, and a deposition method for an insulating coating.

The substrate mounting stand for a plasma processing device

includes an electrostatic chuck section 8 for holding a processing target substrate, and a base 7 for supporting the electrostatic chuck section 8, wherein the base 7 comprises a relatively higher protruding section 72, and an outer peripheral surface 71 that is provided around the periphery of the protruding section 72 at a position that is a predetermined level lower than the protruding section 72. A sprayed coating 76 is deposited onto the outer peripheral surface 71 in a film thickness equivalent to the height difference between the protruding section 72 and the outer peripheral surface 71, so that the protruding section 72 and the surface of the sprayed coating 76 form a continuous flat surface. The electrostatic chuck section 8 is composed of an electrode 82 disposed between insulating members 81, 83 and 84, and this electrostatic chuck section 8 is secured to the base 7 with an adhesive 9 so as to cover the seam between the upper surface of the protruding section 72 and the surface of the sprayed coating 76.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第（ 2(E) ）圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

7～基座部

8～靜電吸盤部

9～黏接劑

76～噴敷皮膜

81～絕緣性構件(絕緣性基板)

82～電極(金屬膜)

83～絕緣性構件(低電阻陶瓷噴敷皮膜)

84～絕緣性構件(高電阻陶瓷噴敷皮膜)

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

(無)

七、申請專利範圍：

1.一種電漿處理裝置用基板載置台，包含：

基座，由下列部分構成頂面：第 1 面、該第 1 面周圍之較低既定高度之位置所形成的第 2 面、及膜厚相同於該既定高度且與該第 1 面連接而形成於該第 2 面上的絕緣皮膜；

靜電吸盤部，固定於該基座之頂面以固持待處理基板。

2.如申請專利範圍第 1 項之電漿處理裝置用基板載置台，其中，包含形成於該基座之該第 1 面及該第 2 面之分界的傾斜面。

3.如申請專利範圍第 1 或 2 項之電漿處理裝置用基板載置台，其中，該絕緣皮膜為陶瓷膜。

4.一種電漿處理裝置，其特徵為：

包含申請專利範圍第 1 至 3 項中任一項之電漿處理裝置用基板載置台。

5.一種絕緣皮膜之成膜方法，在具有第 1 面、及比該第 1 面低既定高度之位置所形成之第 2 面的基座，將膜厚相同於該既定高度並與該第 1 面連接而形成於該第 2 面上之該絕緣皮膜成膜；

包含：

於該表面上將該絕緣皮膜噴敷的步驟；

藉由去除位於該表面上之比該第 1 面上方的絕緣皮膜，以使該絕緣皮膜之膜厚一致於該既定高度的步驟。

6.如申請專利範圍第 5 項之絕緣皮膜之成膜方法，其中，包含在該第 1 面及該第 2 面之間形成傾斜面的步驟。

7.如申請專利範圍第 5 或 6 項之絕緣皮膜之成膜方法，其中，該第 2 面位在該第 1 面之周圍，且包含將除該第 1 面之周緣以外，於該

第 1 面上以遮蔽構件遮蔽之步驟；

該將絕緣皮膜噴敷的步驟，將除該遮蔽構件上以外的部分噴敷該絕緣皮膜。

8.如申請專利範圍第 7 項之絕緣皮膜之成膜方法，其中，包含將該第 1 面上之周緣、該第 2 面、及該傾斜面粗糙化的步驟。

八、圖式：

第 1 面上以遮蔽構件遮蔽之步驟；

該將絕緣皮膜噴敷的步驟，將除該遮蔽構件上以外的部分噴敷該絕緣皮膜。

8.如申請專利範圍第 7 項之絕緣皮膜之成膜方法，其中，包含將該第 1 面上之周緣、該第 2 面、及該傾斜面粗糙化的步驟。

八、圖式：

圖式

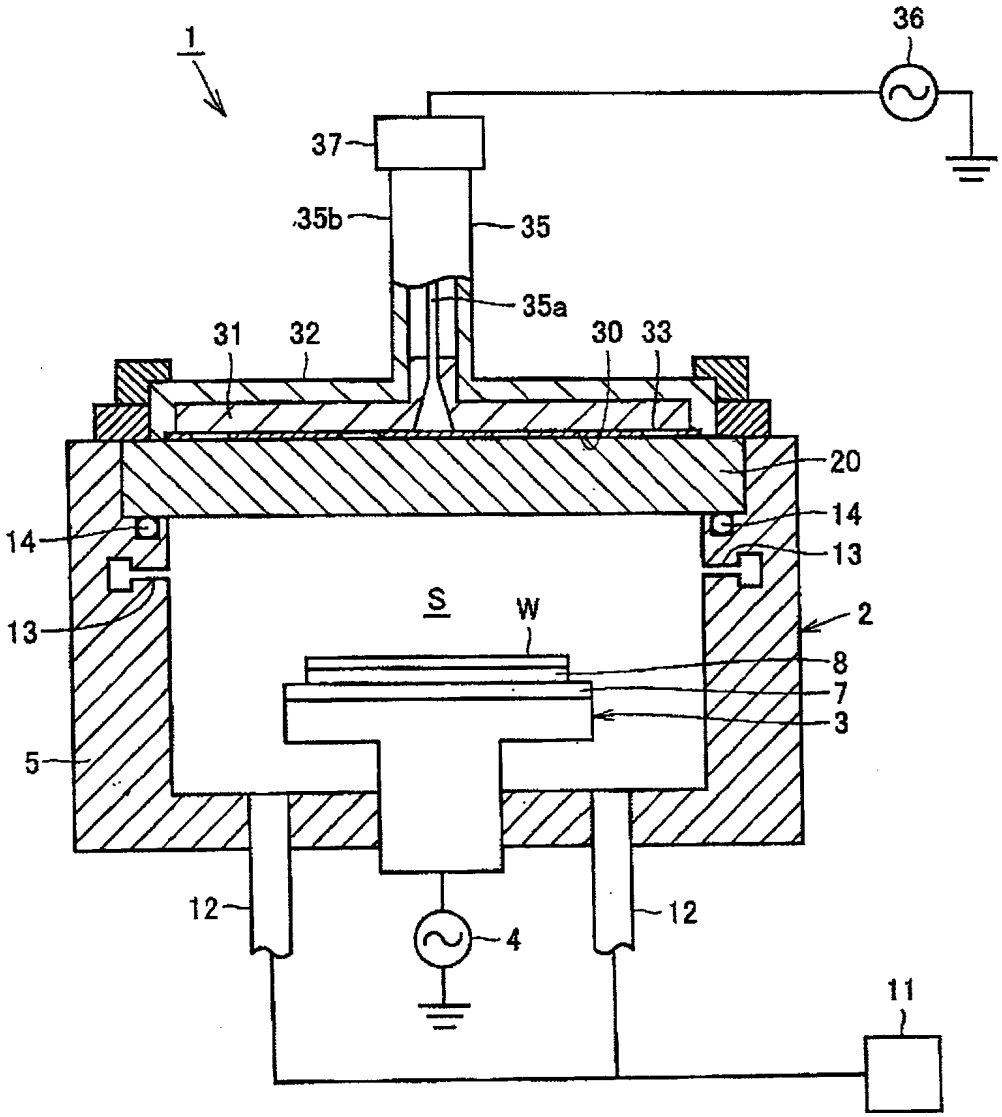


圖 1

圖式

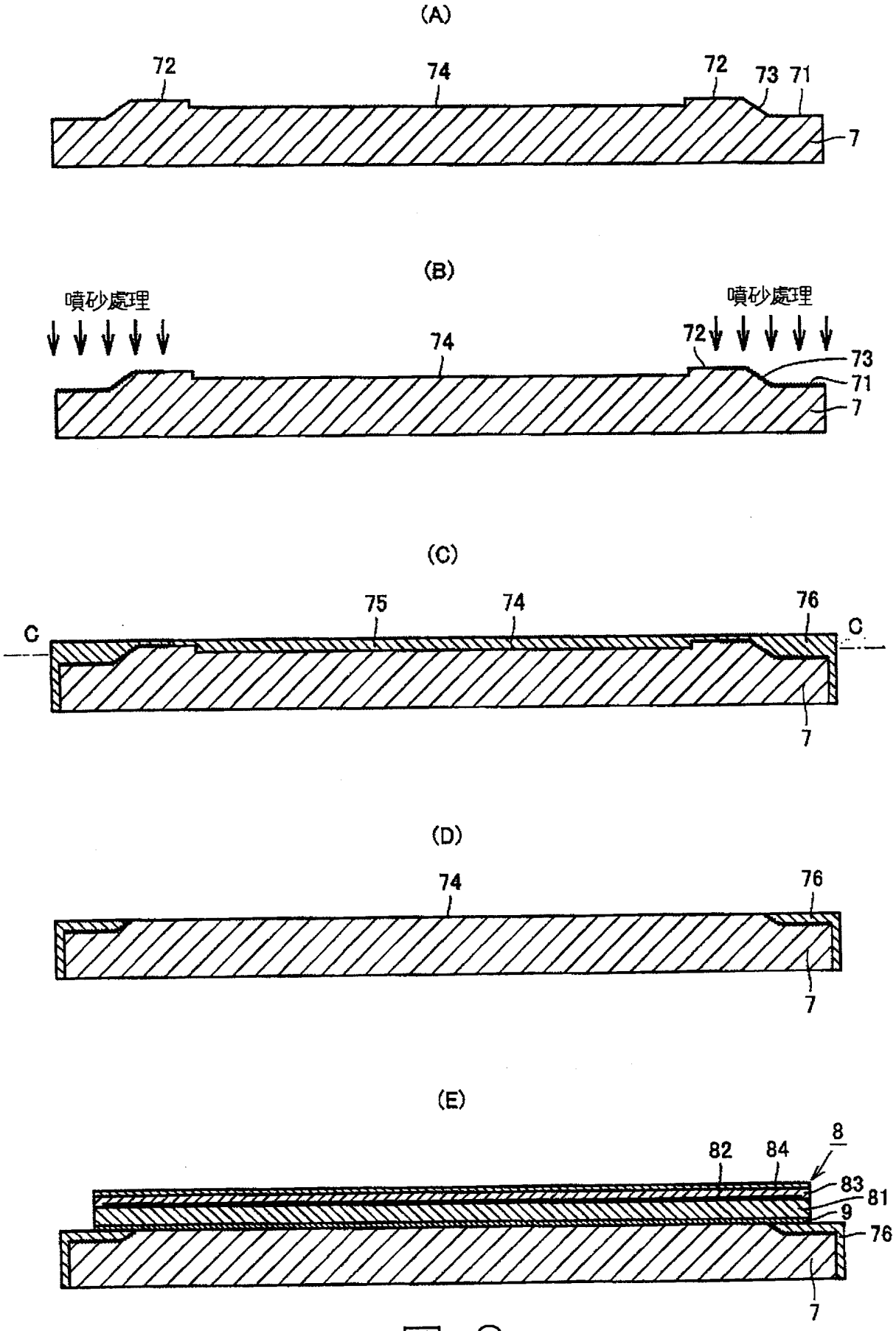

(A)
72
74
72
73
71
7
(B)
噴砂處理
噴砂處理
74
72
73
71
7
(C)
75
74
76
C
C
7
(D)
74
76
7
(E)
8
82
84
83
81
9
76
7

圖 2

includes an electrostatic chuck section 8 for holding a processing target substrate, and a base 7 for supporting the electrostatic chuck section 8, wherein the base 7 comprises a relatively higher protruding section 72, and an outer peripheral surface 71 that is provided around the periphery of the protruding section 72 at a position that is a predetermined level lower than the protruding section 72. A sprayed coating 76 is deposited onto the outer peripheral surface 71 in a film thickness equivalent to the height difference between the protruding section 72 and the outer peripheral surface 71, so that the protruding section 72 and the surface of the sprayed coating 76 form a continuous flat surface. The electrostatic chuck section 8 is composed of an electrode 82 disposed between insulating members 81, 83 and 84, and this electrostatic chuck section 8 is secured to the base 7 with an adhesive 9 so as to cover the seam between the upper surface of the protruding section 72 and the surface of the sprayed coating 76.

四、指定代表圖：

(一)本案指定代表圖為：第（ 2(E) ）圖。

(二)本代表圖之元件符號簡單說明：

7～基座部

8～靜電吸盤部

9～黏接劑

76～噴敷皮膜

81～絕緣性構件(絕緣性基板)

82～電極(金屬膜)

83～絕緣性構件(低電阻陶瓷噴敷皮膜)

84～絕緣性構件(高電阻陶瓷噴敷皮膜)

五、本案若有化學式時，請揭示最能顯示發明特徵的化學式：

(無)